

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人

菅原 正倫

様

あて名

〒 460-0008

愛知県名古屋市中区栄二丁目9番30号
栄山吉ビル 菅原国際特許事務所

PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]

発送日
(日.月.年)

29. 6. 2004

出願人又は代理人
の書類記号

PCT0301052S

今後の手続きについては、下記2を参照すること。

国際出願番号

PCT/J P 2004/003498

国際出願日

(日.月.年) 16. 03. 2004

優先日

(日.月.年) 27. 03. 2003

国際特許分類 (IPC)

Int. Cl⁷ H01L 33/00

出願人 (氏名又は名称)

信越半導体株式会社

1. この見解書は次の内容を含む。

☒ 第I欄 見解の基礎

☐ 第II欄 優先権

☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成

☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如

☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明

☐ 第VI欄 ある種の引用文献

☐ 第VII欄 国際出願の不備

☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日

10. 06. 2004

名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)
吉野 三寛

2K

9010

電話番号 03-3581-1101 内線 3253

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____ 語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された P C T 規則 12. 3 及び 23. 1 (b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1 - 8	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1 - 8	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1 - 8	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

文献1 : JP 2003-69076 A(信越半導体株式会社), 2003. 03. 07, 全文, 全図
 文献2 : JP 8-236872 A(日本ビクター株式会社), 1996. 09. 13, [0002], 図1
 文献3 : JP 10-98214 A(財団法人半導体研究振興会), 1998. 04. 14, [0016], 図1
 文献4 : JP 2002-329888 A(信越半導体株式会社), 2002. 11. 15, 全文, 全図

文献1には、MgZnO型酸化物により構成された発光素子が記載されている。
 文献2には、p型のキャリア濃度が得られにくい半導体結晶において、p型基板を用いてn型半導体を上方にした構造の発光素子が記載されている。
 文献3には、n型ドーパントの添加量が多いn型低抵抗層（コンタクト層）を設ける構成が記載されている。
 文献4には、p型のMgZnO型酸化物層をアニール処理する構成が記載されている。

・請求の範囲1 : 文献1 - 4

文献1に記載されている発光素子をp型基板上に形成する構成は当業者には自明な構成であり、コンタクト層にドーパントを多量に添加する構成は当業者が適宜なし得る設計事項である。

・請求の範囲2 - 5 : 文献1 - 4

単なる設計事項に過ぎない。

・請求の範囲6 - 7 : 文献1 - 4

周知な不純物添加手段で規定したに過ぎない。

・請求の範囲8 : 文献1 - 4

当業者が所望によりなし得る構成に過ぎない。